DERWENT-ACC-NO:

1993-106104

DERWENT-WEEK:

199313

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

IC lead frame with high dimensional precision

for

semiconductor device - has inner lead formation

being two

waves with bends in different directions

NoAbstract

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO METAL MINING CO [SUMM]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0223443 (August 8, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 05047980 A February 26, 1993 N/A

003 H01L 023/50

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 05047980A N/A 1991JP-0223443

August 8, 1991

INT-CL (IPC): H01L023/50

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 05047980A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/5

TITLE-TERMS: IC LEAD FRAME HIGH DIMENSION PRECISION SEMICONDUCTOR

DEVICE INNER

LEAD FORMATION TWO WAVE BEND DIRECTION NOABSTRACT

ADDL-INDEXING-TERMS:

INTEGRATED CIRCUIT

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-D03A1A;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1993-080412

(19)日本国特計 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-47980

(43)公開日 平成5年(1993)2月26日

(51)Int.CL⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/50

K 9272-4M

B 9272-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特顯平3-223443

(22)出願日

平成3年(1991)8月8日

(71)出願人 000183303

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋5丁目11番3号

(72)発明者 徳永 司

東京都西多摩郡羽村町栄町1丁目2番10号

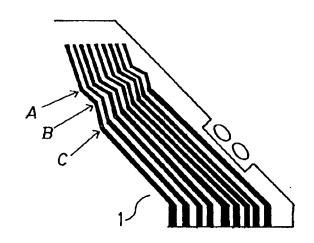
(74)代理人 弁理士 小林 英一

(54)【発明の名称】 半導体装置用 I Cリードフレーム

(57)【要約】

【目的】 プレス打ち抜き加工によって製造する半導体 装置用ICリードフレームの寸法精度を向上する。

【構成】 半導体装置用ICリードフレームの内部リー ドの形状を、二個所以上の、方向の異なる屈曲部を有す る波型形状に構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体装置用 I Cリードフレームの内部 リードの形状を、二個所以上の、方向の異なる屈曲部を 有する波型形状に構成することを特徴とする半導体装置 用ICリードフレーム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置用ICリー ドフレームの内部リードの形状に関するものである。 [0002]

【従来の技術】従来、半導体装置用ICリードフレーム の内部リードの形状は、図2に示すように一個所の屈曲 部Dを有し、その先はパッド方向に向かって直線的に延 びるように構成されている。また、図3に示すように二 個所以上の屈曲部を有する場合でも同一方向に屈曲する ように構成されており、方向の異なる屈曲部を有する波 型形状に構成するものは製造されていなかった。

【0003】他方、プレス打ち抜き加工によって半導体 装置用ICリードフレームを製造する場合、図4および 図5に示すように内部リード形状の凸側と凹側とでは、 プレス打ち抜き加工による塑性的な縮みに差があるの で、同一方向に屈曲した形状では、プレス打ち抜き加工 後の内部リードの変形や位置ずれを起こすことになり、 半導体装置用ICリードフレームの寸法精度を劣化させ るという問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のよう な課題を解決するためになされたもので、二個所以上 の、方向の異なる屈曲部を設けて波型形状に構成するこ とによって、内部リードの左右の辺に生じる塑性的な縮 30 あり、表1の数値は30個所の測定値の平均値である。 みの差を小さくして、内部リードの左右の辺に与えられ る応力の差を均等に近づけ、プレス打ち抜き加工後の内 部リードの変形や位置ずれを防止し、半導体装置用IC リードフレームの寸法精度を向上することを課題とする ものである。

* [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体装置用 ICリードフレームの内部リードの形状を、二個所以上 の、方向の異なる屈曲部を有する波型形状に構成するこ とを特徴とする半導体装置用ICリードフレームであ る。

2

[0006]

【作用】図4および図5は、半導体装置用ICリードフ レームの曲げ加工時の屈曲部の応力状態を示す線図およ 10 V説明図である。すなわち、屈曲部の角度 θ が180° 以下では屈曲部から流れだす方向に、また、180°以 上では流れ込む方向に応力が働く。この両方向の応力は **均等ではないので、加工後の変形の原因となる。本発明** では、このような屈曲部を二個所以上設けることによっ てバランスをとり、加工後の変形や位置ずれを防止でき るように構成したものである。

[0007]

【実施例】図1に示す本発明にかかる半導体装置用 I C リードフレームにしたがって実施例を説明する。 図1は 20 QFPタイプの半導体装置用ICリードフレームに適用 した例を示したもので、内部リード先端のポンディング エリア(プレス加工時のコイニングエリア)を除いた部 分で、方向の異なる屈曲部A、BおよびCを設けてあ

【0008】発明者は、リードピッチを種々変えた場合 の半導体装置用ICリードフレームの寸法精度の変化 を、リード寄り量の変化として把握して製造実験をおこ ない、表1に示すような実験結果をえた。 ここで、リー ド寄り量とは、設定値と実測値とのずれの寸法のことで また、リード幅は、(リードピッチ×0.5)とし、ま た、抜き幅は、(リードピッチ×0.5)とし、各屈曲 部の角度は22°として実験をおこなった。

[0009]

【表1】

リードピッチ (mm)	リード寄り量(平均値) (mm)	
	実 施 例	従来例(直線状)
0.26	0.020	0.070
0. 24	0.010	0. 055
0. 22	0. 015	0. 070

【0010】表1から明らかなように、本発明による と、リード寄り量 (平均値) は従来法の1/3~1/5 程度まで減少することができ、半導体装置用ICリード フレームの寸法精度を飛躍的に向上することができた。※50 ることができ、パンチの寿命を延長するとともに生産性

※なお、この時使用する打ち抜きパンチの形状は、同様に 波型形状となり、従来の直線状のパンチに比較して、プ レス打ち抜き加工時に打ち抜きパンチのたわみを減少す

特開平5-47980

を向上することができた。

[0011]

【発明の効果】以上のように、本発明によると、半導体 装置用ICリードフレームの寸法精度を飛躍的に向上す ることができるとともに、プレス用パンチの寿命を延長 する効果も奏することができる。

3

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる半導体装置用 I Cリードフレー ムの斜視図である。

【図2】従来の半導体装置用ICリードフレームの一例 10 C 第三の屈曲部 を示す斜視図である。

【図3】従来の半導体装置用 I Cリードフレームの一例

を示す平面図である。

(3)

【図4】本発明の作用を説明する屈曲部の応力状態を示 す線図である。

4

【図5】本発明の作用を説明する屈曲部の応力状態を示 す説明図である。

【符号の説明】

1 半導体装置用ICリードフレーム

A 第一の屈曲部

B 第二の屈曲部

D 屈曲部

θ 屈曲部の角度

